

(4)



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

⑪ Veröffentlichungsnummer:

0 328 886
A2

⑯

⑯

⑯ Anmeldenummer: 89100805.4

⑯ Anmeldetag: 18.01.89

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

⑯ Int. Cl. 4 G02B 6/12

⑯ Priorität: 19.02.88 DE 3805278

⑯ Veröffentlichungstag der Anmeldung:
23.08.89 Patentblatt 89/34

⑯ Benannte Vertragsstaaten:
DE FR GB

⑯ Anmelder: Siemens Aktiengesellschaft
Wittelsbacherplatz 2
D-8000 München 2(DE)

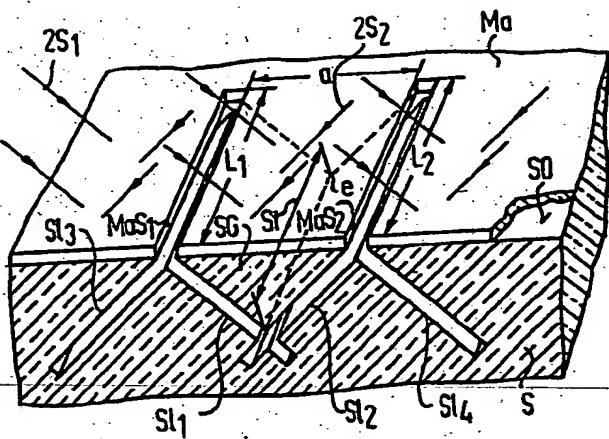
⑯ Erfinder: Matz, Richard, Dr.
Nangerstrasse 24a
D-8152 Feldkirchen/Westerham(DE)
Erfinder: Zirrglebel, Jutta
Öfelstrasse 13a
D-8000 München 90(DE)

④ Isoliereinrichtung zum optischen Isolieren integrierter Komponenten.

⑤ Komponenten auf Substraten für die integrierte Optik müssen optisch vom Substrat entkoppelt werden. Es wird dazu eine Isoliereinrichtung angegeben, mit welcher integrierte Komponenten auf InP weitgehend von den im Substrat übertragenen optischen Störungen entkoppelt werden können.

Dazu besteht die Isoliereinrichtung (J) aus wenigstens zwei in der Substratoberfläche (SO) ausgebildeten, von dieser Oberfläche (SO) schräg in Richtung aufeinander zu in die Tiefe gehenden und im Inneren des Substrats (S) auf einer durch ihre Länge (L_1 , L_2) bestimmten Strecke (St) sich kreuzenden Schlitten (Sl₁, Sl₂), die ein zwischen ihnen liegendes Substratgebiet (SG) auf der bestimmten Strecken (St) vom Substrat (S) trennen und auf beiden Enden dieser Strecke (St) eine monolithische Verbindung dieses Gebietes (SG) mit dem Substrat (S) belassen.

FIG 1



EP 0 328 886 A2

Isoliereinrichtung zum optischen Isolieren integrierter Komponenten

Die Erfindung betrifft gemäß dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 eine Isoliereinrichtung zum optischen Isolieren von auf einem Substrat für die integrierte Optik integrierten Komponenten.

Für die optische Nachrichtenübertragung werden integriert optische Komponenten auf InP-Basis als kostengünstig angesehen, weil planare Technologie Mikrooptik und Mikromechanik ersetzt. Als Folge der Integration nimmt allerdings die Wechselwirkung zwischen den einzelnen Bauelementen zu, so daß es zu unerwünschtem Nebensprechen zwischen verschiedenen Übertragungskanälen kommt. Integration ist deshalb nur in dem Maße sinnvoll, wie es gelingt, Bauelementstrukturen mit hoher Nebensprechdämpfung zu realisieren.

Zur Verbesserung der elektrischen Nebensprechdämpfung können für epitaktisch gewachsene Bauelemente semiisolierende Substrate, Trenngräben und zusätzlich Abschirmelektroden verwendet werden. In der integrierten Optik sind außerdem Maßnahmen gegen optisches Nebensprechen zu treffen. Hierfür werden auf Substraten aus InP manchmal lichtabsorbierende InGaAs-Schichten eingesetzt (siehe dazu beispielsweise C. Bornholdt et al, Electron. Lett. 23, 2 (1987)). Die für völlige Absorption nötige Schichtdicke ist mit den üblichen Epitaxieverfahren nicht realisierbar. Auch einzelne Trenngräben erscheinen wenig aussichtsreich, da sich Streulicht aufgrund des hohen Brechungsinde-
xes durch Mehrfachreflexion im Kristall gleichmäßig verteilt.

Aufgabe der Erfindung ist es, eine Isoliereinrichtung der eingangs genannten Art anzugeben, mit welcher integrierte Komponenten weitgehend von den im Substrat übertragenen optischen Störungen entkoppelt werden können.

Diese Aufgabe wird durch die im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1 angegebenen Merkmale gelöst.

Bei der erfindungsgemäßen Isoliereinrichtung kann ein an der Oberfläche des zwischen den Schlitzten liegenden Substratgebietes integriertes Element, beispielsweise eine Photodiode, von dem Strahl im Substrat besser entkoppelt werden. Das genannte Substratgebiet wird vorzugsweise an zwei Enden monolithisch mit dem Substrat verbunden, so daß hier auch Kontakte für aktive Elemente zugeführt werden können. Streulicht kann nur über diese Enden und mit geringer Transmission auch durch die Schlitzte in das Substratgebiet gelangen.

Die erfindungsgemäße Isoliereinrichtung kann vorteilhafterweise auf Substraten aus InP realisiert werden (Anspruch 2).

Zur weiteren Reduzierung der geringen Transmission durch die Schlitzte ist es zweckmäßig,

wenn ein Schlitz mit Metall (Anspruch 3) oder auch mit ternärem Absorbermaterial (Anspruch 4) gefüllt ist. Ein solches Auffüllen verbessert die thermische Ankopplung, und die sonst bestehende Forderung nach geringer Verlustleistung des isolierten Bauelements kann entfallen.

Die erfindungsgemäße Isoliereinrichtung läßt sich auf einfache Weise durch das im Anspruch 5 angegebene Verfahren herstellen. Ein Füllen der Schlitzte mit Metall oder ternärem Absorbermaterial oder auch einem anderen Material kann nach der Herstellung erfolgen. Das Füllen durch Metall kann durch eine Metallabscheidung erfolgen.

Ein Ausführungsbeispiel der Erfindung wird anhand der Figuren in der folgenden Beschreibung näher erläutert. Von den Figuren zeigen:

Figur 1 eine perspektivische Darstellung einer erfindungsgemäßen Isoliereinrichtung; und

Figur 2 und Figur 3 jeweils einen senkrecht zur Längsrichtung der Schlitzte geführten Schnitt durch die Einrichtung nach Figur 1, wobei die Schlitzte mit Metall bzw. ternärem Absorbermaterial gefüllt sind.

Beim Ausführungsbeispiel nach Figur 1 sind die beiden in der Substratoberfläche SO mit Abstand d nebeneinander verlaufend ausgebildeten, von dieser Oberfläche SO in Richtung aufeinander zu in die Tiefe gehenden Schlitzte Sl₁ und Sl₂ an der Substratoberfläche durch zwei streifenförmige Ausnehmungen MaSl₁ und MaSl₂ einer auf die Substratoberfläche SO aufgebrachten Schattenmaske Ma definiert. Die Länge der Ausnehmung MaSl₁ entspricht der Länge L₁ des durch sie definierten Schlitzes Sl₁. Die Länge der Ausnehmung MaSl₂ entspricht der Länge L₂ des durch sie definierten Schlitzes Sl₂.

Die beiden Schlitzte Sl₁ und Sl₂ kreuzen sich im Inneren des Substrats S auf einer durch ihre Länge L₁ und L₂ bestimmten Strecke St.

Die beiden Schlitzte Sl₁ und Sl₂ bilden gemeinsam die Isoliereinrichtung J, welche das zwischen den Schlitzten Sl₁ und Sl₂ liegende, im Profil dreieckförmige Substratgebiet SG auf der bestimmten Strecke St vom Substrat S trennen und an zumindest einem Ende dieser Strecke eine monolithische Verbindung des Gebiets SG mit dem Substrat S belassen. In der Praxis wird meist an beiden Enden der Strecke St eine monolithische Verbindung des Substratgebietes SG mit dem Substrat S belassen, so daß dieses Gebiet SG eine Brücke bildet.

An der Oberfläche des vom Substrat optisch isolierten Substratgebietes SG können eine oder mehrere aktive oder passive Komponenten inte-

griert sein oder w^{rden}, die optisch vom Substrat S entkoppelt sind.

Die Herstellung der Isoliereinrichtung J kann so erfolgen, daß die Schlitze Sl₁ und Sl₂ durch laserinduziertes, naßch misches Ätzen mit zwei schräg in Richtung aufeinanderzu auf die Substratoberfläche SO gerichteten Lichtstrahlen LS₁ und LS₂ erzeugt werden, wobei die Ausnehmungen MaSl₁ und MaSl₂ dafür sorgen, daß die Lichtstrahlen nur in diesen Ausnehmungen auf die Substratoberfläche SO auftreffen. Die Lichtstrahlen LS₁ und LS₂ sollten zumindest nahezu parallel sein. Mit Hilfe dieser Lichtstrahlen LS₁ und LS₂ wird solange in die Tiefe des Substrats S geätzt, bis die entstehenden Schlitze Sl₁ und Sl₂ im Inneren des Substrats S ineinandermünden oder sich kreuzen.

Beim Beispiel nach Figur 1 trifft jeder Lichtstrahl LS₁ bzw. LS₂ beide Ausnehmungen MaSl₁ und MaSl₂, so daß neben den Schlitzen Sl₁ und Sl₂ zwei zusätzliche Schlitze Sl₃ und Sl₄ entstehen, die von der Substratoberfläche SO schräg in Richtung voneinander fort in die Tiefe gehen.

Das laserinduzierte, naßchemische Ätzen ist beispielsweise aus Appl. Phys. Lett. 47 (3), Aug. 1985, S. 269-271 bekannt und braucht deshalb hier nicht näher beschrieben werden.

Bei einem Ausführungsbeispiel wurden zwei im Abstand von 200 μm nebeneinanderliegende Substratgebiete SG in n-dotiertem InP-Substrat-(100)-Oberfläche erzeugt. Die Schlitze Sl₁ und Sl₂ wurden durch laserinduziertes, naßchemisches Ätzen mit zwei aufgeweiteten, symmetrisch unter 45° auf die Substratoberfläche SO einfallenden und in sich nahezu parallelen Lichtstrahlen geätzt. Die Lichtwellenlänge und die Lichtintensität betrugen 488 nm bzw. 180 mW/cm² je Strahl. Als Schattenmaske Ma diente ein aufgedampfter Titanfilm, in dem durch Lift-Off Paare von 3 bis 8 μm breiten Ausnehmungen MaSl₁ und MaSl₂ geöffnet waren. Der Abstand d der Ausnehmungen MaSl₁ und MaSl₂ betrug 50 μm . Durch lokales Überdampfen mit Chrom wurden die Ausnehmungen MaSl₁ und MaSl₂ und damit auch die Substratgebiete SG auf eine Länge L₁ und L₂ von 1000 μm begrenzt. Die erforderliche Tiefe der Schlitze Sl₁ und Sl₂ von 35 bis 40 μm wurde in HCl : HNO₃ : H₂O = 1 : 1 : 20 als Ätzlösung bei 0,7 Volt anodischem Probenpotential, bezogen auf eine Kalomelelektrode, in 30 Minuten erreicht.

Für die Isolation realer Bauelemente kann eine ohnehin vor handene Kontaktmetallisierung als Schattenmaske Ma dienen. Da p-dotiertes Material im Gegensatz zu n-dotiertem Material in der Ätzlösung von sichtbarem Licht nicht angegriffen wird, können auch p-dotierte Epitaxieschichten als Schattenmaske Ma für das Verfahren dienen.

Ein eventuelles Auffüllen der Schlitze Sl₁ und Sl₂ mit Metall oder mit t_marem Absorb material kann nach ihrer Herstellung erfolgen.

5

Ansprüche

1. Isoliereinrichtung (J) zum optischen Isolieren von auf einem Substrat (S) für die integrierte Optik optischen Komponenten, dadurch gekennzeichnet,
daß die Isoliereinrichtung (J) aus wenigstens zwei in der Substratoberfläche (SO) mit Abstand (d)
nebeneinander verlaufend ausgebildeten, von dieser Oberfläche (SO) schräg in Richtung aufeinander zu in die Tiefe gehenden und im Inneren des Substrats (S) auf einer durch ihre Länge (L₁, L₂) bestimmten Strecke (St) ineinandermündenden Schlitzen (Sl₁, Sl₂) besteht, die ein zwischen ihnen liegendes Substratgebiet (SG) auf der bestimmten Strecke (St) vom Substrat (S) trennen und an zumindest einem Ende (e) dieser Strecke (St) eine monolithische Verbindung des Gebiets (SG) mit dem Substrat (S) belassen.
2. Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß das Substrat (S) aus InP besteht.
3. Einrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Schlitz (Sl₁, Sl₂) ein Metall (M) vorgesehen ist.
4. Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet, daß in einem Schlitz (Sl₁, Sl₂) ein ternäres Absorbermaterial (tA) vorgesehen ist.
5. Verfahren zur Herstellung einer Einrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprüchen, dadurch gekennzeichnet,
daß die Schlitze (Sl₁, Sl₂) durch laserinduziertes, naßchemisches Ätzen mit zwei schräg in Richtung aufeinander zu auf die Substratoberfläche (SO) gerichteten und nur in mit Abstand nebeneinander verlaufenden, die Schlitze (Sl₁, Sl₂) in der Substratoberfläche (SO) definierenden, streifenförmigen Bereichen (MaSl₁, MaSl₂) auf die Substratoberfläche (SO) auftreffenden Lichtstrahlen (LS₁, LS₂) erzeugt werden, wobei solange in die Tiefe geätzt wird, bis die entstehenden Schlitze (Sl₁, Sl₂) im Inneren des Substrats (S) ineinandermünden oder sich schneiden.

50

55

3

FIG 1

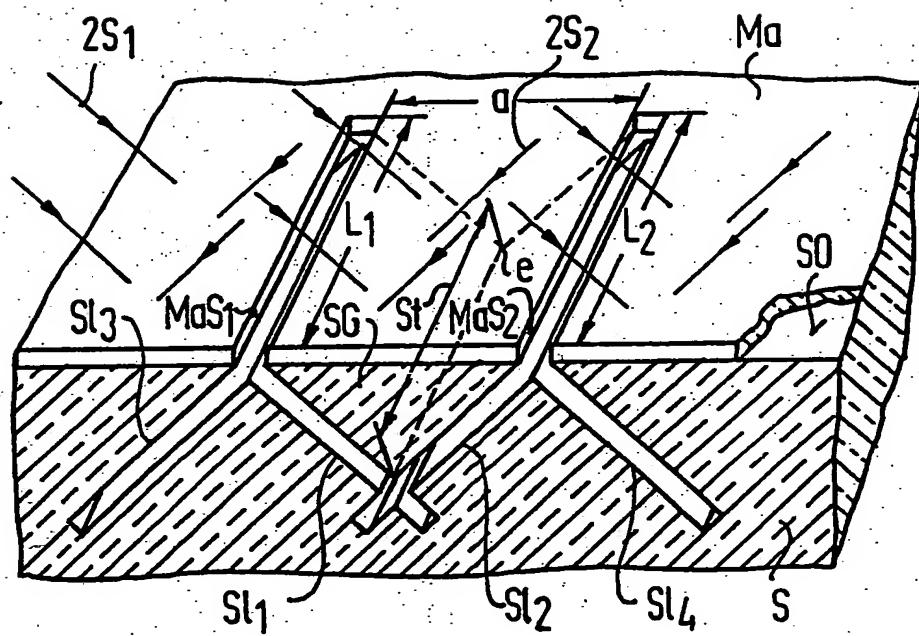


FIG 2

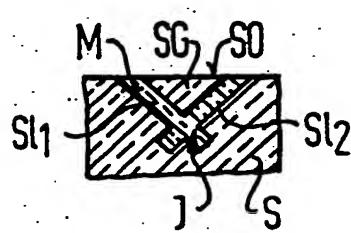


FIG 3

